1

手続補正書(法第11条の規定による補正)



特許庁審査官 河口 雅英 殿

- 国際出願の表示 PCT/JP03/05334
- 2. 出願人

名称 サンケン電気株式会社 SANKEN ELECTRIC CO., LTD.

あて名 〒352-8666 日本国埼玉県新座市北野3丁目6番3号 6-3, Kitano 3-chome, Niiza-shi, Saitama 352-8666, JAPAN

国籍 白本国 Japan

住所 日本国 Japan

3. 代理人

あて名

氏名 (9540) 弁理士 木村 満



KIMURA Mitsuru

7番地 協販ビル2階

〒101-0054

2nd Floor, Kyohan Building, 7, Kandanishiki-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, JAPAN

日本国東京都千代田区神田錦町二丁目

4. 補正の対象 請求の範囲

5. 補正の内容

(1)請求の範囲第1項

第8行「前記第2の半導体領域(3)を介して」との記載を追加した。

第10行「前記第1の半導体領域(2)と前記第2の半導体領域(3)と前記第3の半導体領域(6)とによってリサーフ構造が形成される」との記載を追加した。

第14行「隣接して」との記載を追加した。

第15行「前記リサーフ構造を形成する前記第3の半導体領域(6)の」との 記載を追加した。

第18行および第19行「第2の」と誤記を訂正した。

第20行「ために電荷量が該周縁部(6b)の真下の該第2半導体領域(3) の電荷量よりも少ない」との記載を削除した。

(2)請求の範囲第3項

第2行および第3行「第2の」と誤記を訂正した。

従属先を請求項1に変更した。

(3)請求の範囲第4項

第5行「前記第3の半導体領域(6)は、前記第2の半導体領域(3)の表面の略中央に形成されており」との記載を削除した。

第6行「、前記中央部(6a)は、前記第4の半導体領域の真下に形成され」 との記載を追加した。

従属先を請求項1に変更した。

(4)請求の範囲第5項

第8行「第2の半導体領域(3)の外周縁に形成された第1導電型の」との記載を追加した。

第10行「第5の半導体領域(8)上に形成された」との記載を追加した。

第11行「第4の半導体領域(7)上に形成された」との記載を追加した。

(5)請求の範囲第6項

従属先を請求項1に変更した。

(6)請求の範囲第7項

「前記中央部(6 a)の真下に配置された前記第2の半導体領域(3)の電荷量が該周縁部(6 b)の真下の該第2の半導体領域(3)の電荷量よりも少ない」との内容に補正した。

(7)請求の範囲第8項

第3行「、前記第1の半導体領域(2)と前記第2の半導体領域(3)と前記第3の半導体領域(6)とがリサーフ構造を構成するよう」との記載を、元の請求の範囲第7項の内容に追加したものを新たな請求項として追加した。

6. 添付書類の目録

請求の範囲第13、13/1、14、14/1、15頁